

LA2600



No.666A

2041

モノリシックリニア集積回路 デュアルアッテネータ(電子ポリウム)

◇ 半導体ニュース No.666 とさしかえてください。

- 特長**
- ・動作電源電圧範囲が広い。
 - ・入力電圧 または 抵抗で利得制御する。
 - ・減衰量の温度変化が小さい。
 - ・減衰カーブが D 型に近い。

- ・減衰量が大きい。
- ・チャンネル間のクロストークが小さい。
- ・減衰時のひずみ率が小さい。

最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

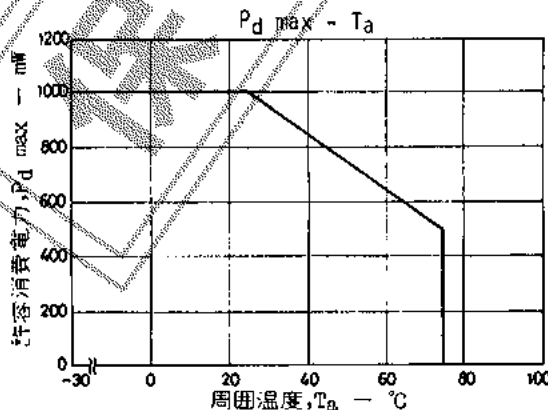
			unit
最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$	16	V
制御入力電圧	V_C	0~6	V
許容消費電力	$P_d \text{ max}$	$T_a \leq 75^\circ\text{C}$ 500	mW
動作周囲温度	T_{opg}	-30~+75	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

推奨動作条件 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

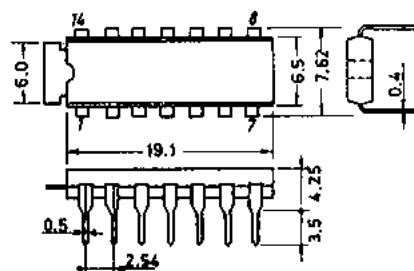
			unit
推奨電源電圧	V_{CC}	12	V
負荷抵抗	R_L	10k	Ω

動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{CC} = 12\text{V}, R_L = 10\text{k}\Omega, f = 1\text{kHz}, R_g = 0$

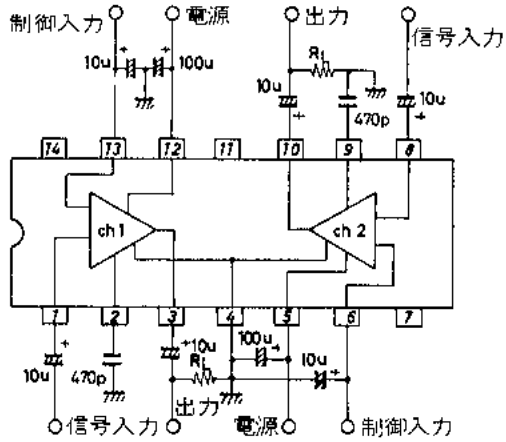
			min	typ	max	unit
電圧利得 (1)	VG1	$V_C = 5\text{V}, v_1 = 100\text{mV}$	11	14	16	dB
電圧利得 (2)	VG2	$V_C = 2.4\text{V}, v_1 = 100\text{mV}$	-40		-18	dB
利得制御範囲		$V_{CC} = 8\sim 16\text{V}, V_C = 0\sim 5\text{V}, v_1 = 500\text{mV}$	80			dB
出力雑音電圧	V_{NO}	$V_C = 0$		20	100	μVrms
全高調波ひずみ率 (1)	THD1	$V_C = 5\text{V}, v_1 = 100\text{mV}$			0.5	%
全高調波ひずみ率 (2)	THD2	$V_C = 5\text{V}, v_1 = 500\text{mV}$			5.0	%
クロストーク	CT	$V_C = 5\text{V}, v_1 = 500\text{mV}$	60			dB
入力抵抗	r_1	$V_C = 5\text{V}, v_1 = 100\text{mV}$	22k			Ω
電圧利得温度特性		$T_a = 25^\circ\text{C}$ 時減衰度40dBにおいて $T_a = -20\sim +60^\circ\text{C}$ 変化したときの 変化幅。		5.2		dB
出力直流電圧	v_o	$V_C = 5\text{V}$	6.0		8.5	V
出力直流電圧変化幅 (Δv_o)		$V_{C1} - V_{C2} = \Delta v$ $V_{C1} \dots V_{C1} = 0\text{V}, V_{C2} \dots V_{C2} = 5\text{V}$			600	mV
制御入力電流		$V_C = 0\text{V}$	-0.33		-0.10	mA
消費電流	I_{CC}			9	14	mA



外形図 3004
(unit: mm)



等価回路ブロック図と周辺回路



ピン配置

- 1. CH1 信号入力
- 2. CH1 周波数補償
- 3. CH1 出力
- 4. GND
- 5. CH2 電源
- 6. CH2 制御入力
- 7. -
- 8. CH2 信号入力
- 9. CH2 周波数補償
- 10. CH2 出力
- 11. -
- 12. CH1 電源
- 13. CH1 制御入力
- 14. -

■ コントロール部,バッファ部を含む総合応用回路

